

ПРОТОКОЛ № 4
заседания диссертационного совета Д 002.205.02
при Физико-техническом ин-те им. А.Ф. Иоффе
от 28 июня 2016 г.

Присутствовали члены совета: Р.А. Сурис, Е.Л. Ивченко, Р.В. Парфеньев, Л.М. Сорокин, Н.С. Аверкиев, И.Н. Арсентьев, Л.Е. Воробьев, Л.Е. Голуб, А.В. Горбатюк, С.А. Гуревич, Г.Г. Зегря, В.И. Иванов-Омский, С.В. Иванов, В.В. Козловский, П.С. Копьев, М.Е. Левинштейн, А.Ю. Маслов, Ю.В. Трушин, Т.В. Шубина, Ю.П. Яковлев.

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

I. Прием к защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

1 Слушали: Прием к защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

Постановили:

(i) Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.10 — физика полупроводников РОЖАНСКОГО И.В. на тему: «Резонансно-туннельные спиновые явления в полупроводниковых гетероструктурах».

Комиссия в составе д.ф.-м. наук Т.В. Шубиной, д.ф.-м. наук А.Ю. Маслова и д.ф.-м. наук Л.Е. Голуба ознакомились с работой соискателя. Комиссия подготовила проект заключения по диссертации. Работу представил член совета д.ф.-м.наук Т.В. Шубина. Диссертация соответствует спец. 01.04.10. Материал диссертации достаточно полно изложен в опубликованных автором работах.

Предлагается назначить ведущей организацией Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Официальными оппонентами утвердить д.ф.-м. наук П.И. Арсеева (Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН), д.ф.-м. наук А.Б. Грановского (МГУ им. М.В. Ломоносова) и д.ф.-м. наук Д.А. Фирсова (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). Согласие официальных оппонентов имеется.

Голосование: за – 20, против – нет, воздержавшихся – нет.

(ii) Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.10 — физика полупроводников РОДИНОЙ А.В. на тему: «Оптические и спиновые явления в полупроводниковых коллоидных нанокристаллах».

Комиссия в составе д.ф.-м.наук Т.В. Шубиной, д.ф.-м.наук Н.С. Аверкиева и д.ф.-м. наук Л.Е. Голуба ознакомились с работой соискателя. Комиссия подготовила проект заключения по диссертации. Работу представил член совета д.ф.-м.наук Т.В. Шубина. Диссертация соответствует спец. 01.04.10. Материал диссертации достаточно полно изложен в опубликованных автором работах.

Предлагается назначить ведущей организацией Санкт-Петербургский Государственный Университет. Официальными оппонентами утвердить д.ф.-м. наук П.А. Арсеева (Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН), д.ф.-м.наук В.Д. Кулаковского (Институт физики твердого тела РАН) и д.ф.-м. наук С.Г. Тиходеева (Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН). Согласие официальных оппонентов имеется.

Голосование: за – 20, против – нет, воздержавшихся – нет.

(iii) Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 — физика полупроводников ЛЕВИНА Р.В. на тему: «Исследования и разработка технологии изготовления гетероструктур на основе антимонида галлия методом ГФЭМОС».

Комиссия в составе д.ф.-м.наук С.А. Гуревич, Г.Г. Зегря, и д.ф.-м. наук П.С. Копьева ознакомились с работой соискателя. Комиссия подготовила проект заключения по диссертации. Работу представил член совета д.ф.-м.наук Г.Г. Зегря. Диссертация соответствует спец. 01.04.10. Материал диссертации достаточно полно изложен в опубликованных автором работах.

Предлагается назначить ведущей организацией Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Южный научный центр Российской академии наук Официальными оппонентами утвердить д.ф.-м. наук Сидоров Валерий Георгиевич (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого), к.ф.-м. наук Петров Александр Сергеевич (ЦНИИ «Электрон»). Согласие официальных оппонентов имеется.

Голосование: за – 20, против – нет, воздержавшихся – нет.

(iv) Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 — физика полупроводников УСОВА С.О. на тему: «Гетероструктуры для светодиодов видимого диапазона и транзисторов с высокой подвижностью электронов на основе квантоворазмерных слоев InGaN, InAlN и короткопериодных сверхрешеток InGaN/GaN».

Комиссия в составе д.ф.-м.наук А.А. Лебедев, С.В. Иванов и д.ф.-м. наук П.С. Копьева ознакомились с работой соискателя. Комиссия подготовила проект заключения по диссертации. Работу представил член совета д.ф.-м. наук П.С. Копьев. Диссертация соответствует спец. 01.04.10.

Материал диссертации достаточно полно изложен в опубликованных автором работах.

Предлагается назначить ведущей Институт аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП РАН) Официальными оппонентами утвердить д.ф.-м. наук Сидоров Валерий Георгиевич (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого), д.ф.-м.наук Мармалюк Александр Анатольевич (Акционерное Общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»). Согласие официальных оппонентов имеется.

Голосование: за – 20, против – нет, воздержавшихся – нет.

Председатель совета
д.ф.-м.н., академик

Р.А. Сурис

Ученый секретарь совета
д.ф.-м.н.

Л.М. Сорокин